

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

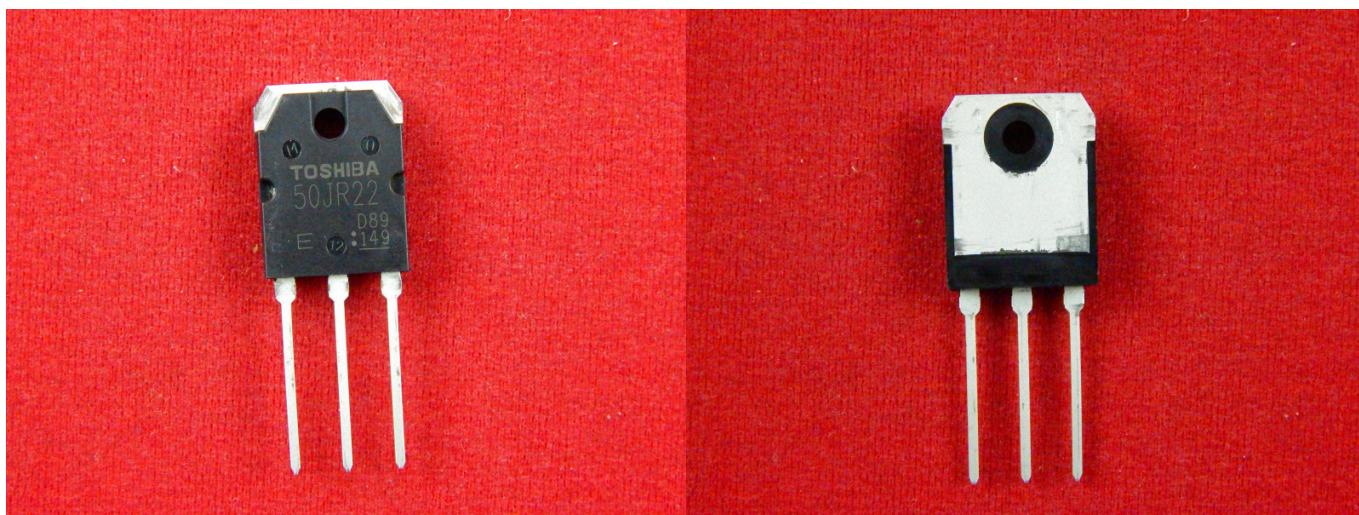
E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18190

Цена в прайсе: 1651 тг.

GT50JR22, Биполярный транзистор IGBT, 600В, 50А, 230Вт



Транзистор – полупроводниковый элемент с тремя выводами (обычно), на один из которых (коллектор) подаётся сильный ток, а на другой (база) подаётся слабый (управляющий ток).

IGBT транзистор - это довольно хитроумный прибор, который представляет собой гибрид полевого и биполярного транзистора. Данное сочетание привело к тому, что он унаследовал положительные качества, как полевого транзистора, так и биполярного.

Спецификация:

- Тип корпуса: TO-3PN;
- Тип подключения: Контакты для пайки;
- Структура транзистора: IGBT;
- Максимальный ток коллектор-эмиттер при 25°C (I_c): 50 А;
- Максимальное напряжение коллектор-эмиттер: 600 В;
- Напряжение насыщения при номинальном токе: 1.55 В;
- Рассеиваемая мощность: 230 Вт;
- Рабочая температура: от -55°C до +175°C;
- Габариты: 40x15x5 мм.